

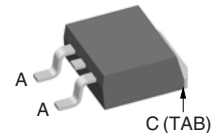
Fast Recovery Epitaxial Diode (FRED)

$$\begin{aligned} V_{RRM} &= 600 \text{ V} \\ I_{FAVM} &= 37 \text{ A} \\ t_{rr} &= 35 \text{ ns} \end{aligned}$$

V_{RSM} V	V_{RRM} V	Type
600	600	DSEI 36-06AS



TO-263 AB



A = Anode, C = Cathode, TAB = Cathode

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
I_{FRMS} I_{FAVM} ① I_{FRM}	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $T_C = 85^\circ\text{C}$; rectangular, $d = 0.5$ $t_p < 10 \mu\text{s}$; rep. rating, pulse width limited by T_{VJM}	70 37 375	A A A
I_{FSM}	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$; $t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine $t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine	300 320	A A
	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$; $t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine $t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine	260 280	A A
I^2t	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$; $t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine $t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine	450 420	A^2s A^2s
	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$; $t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine $t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine	340 320	A^2s A^2s
T_{VJ}		-40...+150	$^\circ\text{C}$
T_{VJM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-40...+150	$^\circ\text{C}$
P_{tot}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	125	W
Weight		2	g

Features

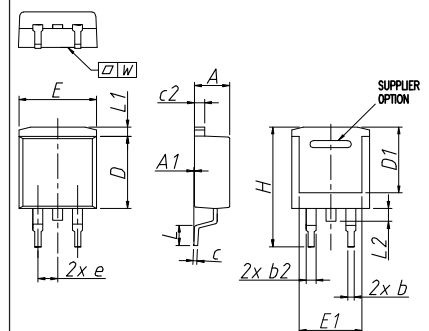
- International standard surface mount package JEDEC TO-263 AB
- Planar passivated chips
- Very short recovery time
- Extremely low switching losses
- Low I_{RM} -values
- Soft recovery behaviour
- Epoxy meets UL 94V-0

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values	
		typ.	max.
I_R	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$ $T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $V_R = 0.8 \cdot V_{RRM}$ $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$ $V_R = 0.8 \cdot V_{RRM}$	100 50 7	μA μA mA
V_F	$I_F = 37 \text{ A}$; $T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$ $T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	1.4 1.6	V V
V_{T0}	For power-loss calculations only	1.01	V
r_T	$T_{VJ} = T_{VJM}$	7.1	$\text{m}\Omega$
R_{thJC}		1.0	K/W
t_{rr}	$I_F = 1 \text{ A}$; $-di/dt = 100 \text{ A}/\mu\text{s}$; $V_R = 30 \text{ V}$; $T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	35	ns
I_{RM}	$V_R = 350 \text{ V}$; $I_F = 30 \text{ A}$; $-di_F/dt = 240 \text{ A}/\mu\text{s}$ $L \leq 0.05 \mu\text{H}$; $T_{VJ} = 100^\circ\text{C}$	10	A

① I_{FAVM} rating includes reverse blocking losses at T_{VJM} , $V_R = 0.8 V_{RRM}$, duty cycle $d = 0.5$

Data according to IEC 60747

TO-263 AB Outline



Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	4.06	4.83	0.160	0.190
A1	typ. 0.10		typ. 0.004	
b	0.51	0.99	0.020	0.039
b2	1.14	1.40	0.045	0.055
c	0.40	0.74	0.016	0.029
c2	1.14	1.40	0.045	0.029
D	8.38	9.40	0.330	0.370
D1	8.00	8.89	0.315	0.350
E	9.65	10.41	0.380	0.410
E1	6.22	8.20	0.245	0.323
e	2.54 BSC		0.100 BSC	
H	14.61	15.88	0.575	0.625
L	1.78	2.79	0.070	0.110
L1	1.02	1.68	0.040	0.066
L2	1.02	1.52	0.040	0.060
W	typ. 0.02	0.040	typ. 0.0008	0.0016

All dimensions conform with and/or are within JEDEC standard.

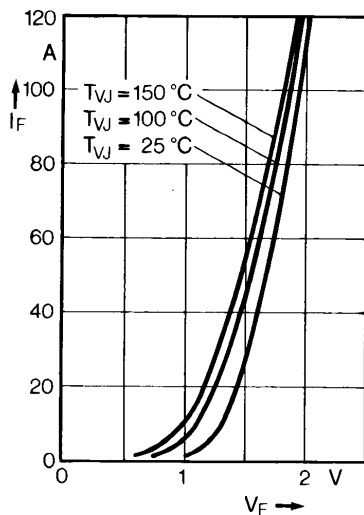


Fig. 1 Forward current versus voltage drop.

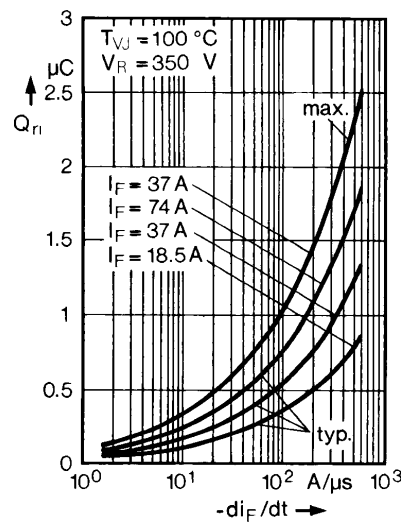


Fig. 2 Recovery charge versus $-di_F/dt$.

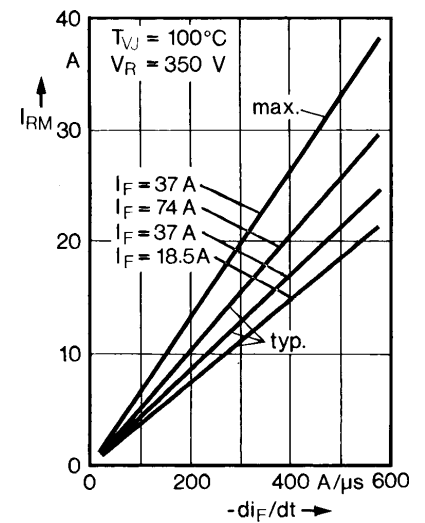


Fig. 3 Peak reverse current versus $-di_F/dt$.

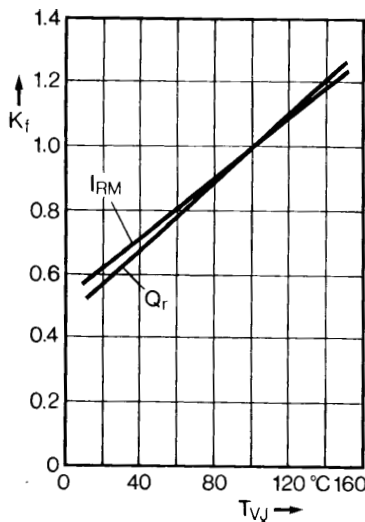


Fig. 4 Dynamic parameters versus junction temperature.

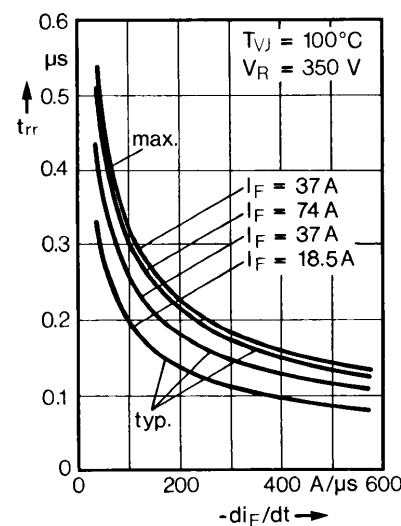


Fig. 5 Recovery time versus $-di_F/dt$.

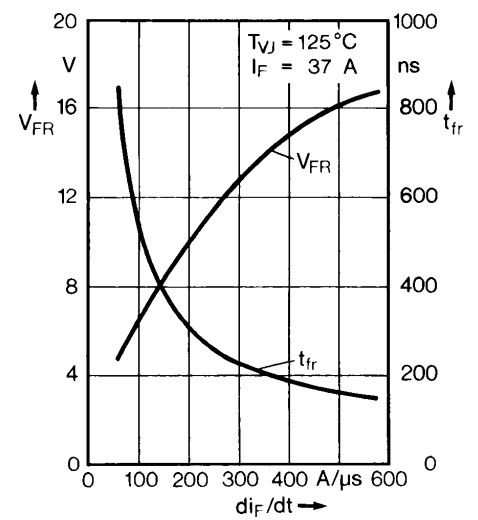


Fig. 6 Peak forward voltage versus di_F/dt .

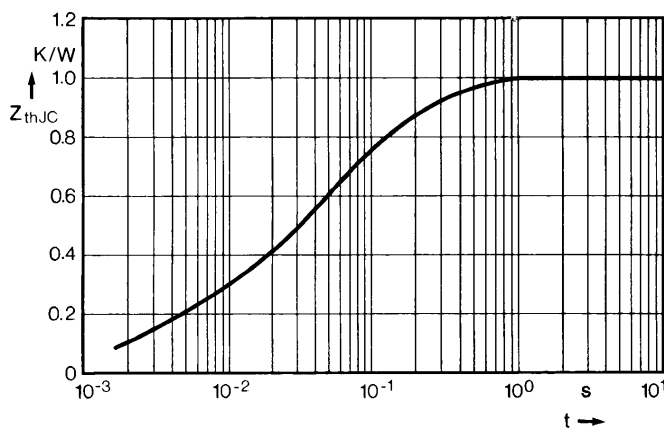


Fig. 7 Transient thermal impedance junction to case.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9